

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成21年9月3日(2009.9.3)

【公開番号】特開2008-53526(P2008-53526A)

【公開日】平成20年3月6日(2008.3.6)

【年通号数】公開・登録公報2008-009

【出願番号】特願2006-229111(P2006-229111)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/3213 (2006.01)

H 0 1 L 21/768 (2006.01)

H 0 1 L 21/302 (2006.01)

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 5 B 33/14 (2006.01)

G 0 2 F 1/1368 (2006.01)

G 0 2 F 1/167 (2006.01)

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/30 5 2 9

H 0 1 L 29/78 6 2 7 C

H 0 1 L 29/78 6 1 6 K

H 0 1 L 29/78 6 1 7 J

H 0 1 L 21/88 C

H 0 1 L 21/90 A

H 0 1 L 21/302 2 0 1 B

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14 A

H 0 5 B 33/14 Z

G 0 2 F 1/1368

G 0 2 F 1/167

G 0 3 F 7/20 5 2 1

【手続補正書】

【提出日】平成21年7月14日(2009.7.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に第 1 の層を形成し、前記第 1 の層上に光吸収層を形成し、  
 前記光吸収層に電気光学素子を通過させたレーザビームを照射し、  
 前記レーザビームが照射された光吸収層の一部を除去して前記第 1 の層の一部を露出し、  
 前記露出された第 1 の層をエッチングして、第 2 の層を形成することを特徴とする半導

体装置の作製方法。

【請求項 2】

基板上に第 1 の層を形成し、前記第 1 の層上に光吸収層を形成し、  
前記光吸収層に電気光学素子を通過させたにレーザビームを照射し、  
前記レーザビームが照射された光吸収層の一部を除去して第 1 の膜厚の光吸収層及び前記第 1 の膜厚より薄い第 2 の膜厚の光吸収層を形成し、  
前記第 1 の膜厚の光吸収層をマスクとして、前記光吸収層及び前記第 1 の層をエッチングして、第 2 の層を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 3】

請求項 1 又は請求項 2 において、  
前記レーザビームが前記電気光学素子を通過することにより、前記光吸収層に照射される前記レーザビームの面積及び位置が選択的に調節されることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 4】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一項において、  
前記電気光学素子は細長い矩形のデジタルマイクロミラーデバイスであることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 5】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一項において、  
前記電気光学素子は細長い矩形の液晶材料を有する素子であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一項において、  
前記電気光学素子は細長い矩形であり、  
前記レーザビームは矩形ビームであり、  
前記矩形ビームの走査に同期するように前記電気光学素子に入力する電気信号を順次変更させることを特徴とする半導体装置の作製方法。